

649461085

*Faxkopia av
original sända med
ord. post idag*

Patent- och Registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm

Ink. t. Patent- och reg.verket

2013 -01- 02

Patentansökan nr 1230011-7

Huvudfaxen Posten

Titel: Silicon carbide crystal growth in a CVD reactor using chlorinated chemistry

Sökande: Erik Janzén, Olof Kordina

Ombud: Solvena Patent AB

Ref: P12-01SE

Vi inkommer härmed med svar på föreläggande utfärdat 2012-07-03 i ovan rubricerade ärende.

I kommentarerna till föreläggandet hänvisas till översättningen till svenska av tidigare ingivet ärende författat på engelska.

Så som granskaren påpekat anges det inte i patentkravet 1 att metoden avser en process som sker i en atmosfär som innehåller klor. Detta har förbisetts tidigare och introduceras härmed. Sålunda införs i patentkravet 1 (rad 12) en precisering att en "kiselkällgas med klor" förs in i reaktionskammaren (1).

Stödet för detta är hämtat från beskrivningens paragraf 38, som säger att: "Andra kiselkällor med klor skulle kunna användas". I detta sammanhang kan nämnas att i den ursprungliga ingivna texten författad på engelska används begreppet "chlorine silicon sources could be chosen", varvid "chlorine silicon sources" till svenska översatts med "kiselkällor med klor". Detta begrepp används företrädesvis före ett införande i patentkrav 1 av särdraget i patentkravet 3, som mer specifikt anger förslag på kiselkällgaser innehållande klor. Patentkravet 3 har anpassats efter sagda översättning för att ha kongruens med bestämningen i patentkravet 1. På motsvarande sätt har bestämmningarna "kiselkällgas med klor" införts i patentkraven 5 och 6 för att beskriva att kiselkällgasen innehåller klor.

Olyckligtvis har i patentkrav 1 i den ursprungliga versionen preciseringen av att det är: "sagda primära och sekundära gasflöden" som väsentligen strömmar parallellt med ytan på substratet. Detta har nu tillrättalagts genom införande av dessa bestämmningar i patentkravet 1, på sätt som granskaren antytt.

Så som granskaren har påpekat framgår det inte av patentkravet 11 hur gasledningarna arrangerats. Detta har nu tillrättalagts genom att bestämmningen:

"att primärgasledningen (14) och sekundärgasledningen (13) är arrangerade så att ett primärgasflöde (16) genom primärgasledningen (14) samt ett sekundärt gasflöde (17) genom sekundärgasledningen (13) strömmar väsentligen parallellt med ytan på substratet".

Postadress
Stjärnevik Solvik
590 46 RIMFORSA

Telefon
0494-61085
070 - 6108512

Org nr
55806-4280

E-postadress
Jan-Erik.Lundmark
@aries.vokby.se

649461085



Nya patentkrav inges med justeringar av bestämmningar enligt ovan.

En särskild bilaga visar vilka ändringar som utförts i patentkraven genom att dessa visats både som understrukna och markerade med gult.

Med dessa ändringar av patentkraven föreligger enligt vår uppfattning inte några hinder mot beviljande av det sökta patentet.

Rimfors, den 2 Januari, 2013

Jan-Erik Lundmark
Solvena Patent AB

Bilagor:

Ändrade patentkrav

Ändrade patentkrav med markering av gjorda ändringar